



Vishay Intertechnology, Inc.

威世

SUPER 12

特色产品

S12



2012





Super 12
特色产品

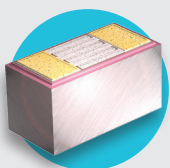
威世



MKP1848S 薄膜电容器

采用薄身外型的薄膜电容器。

2



VCUT05D1-SD0 BiSy 单线 ESD 保护二极管

超小 CLP0603 硅封装。

3

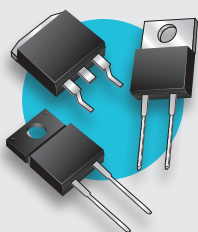


34 THE 非接触式 多匝传感器

真正的 12 位分辨率电源导通位置传感器，角度和输出电压完全可配置。



4



45 V Trench MOS 势垒 肖特基整流器

采用功率封装的 45 V TMBS® 器件，可用于光伏太阳能电池旁路保护。



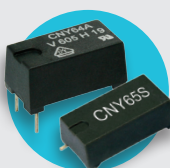
5



MPM 配对 电阻网络

具有严格的比例容差和接近的 TCR 跟踪。

6



CNY6 系列 CAT IV 光耦

CAT IV，用于太阳能电池、风电机组、智能电表和智能电网的连接。



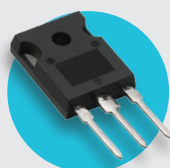
7



IHLP® 3232 系列小尺寸, 高电流电感器

IHLP 产品线的新增尺寸。

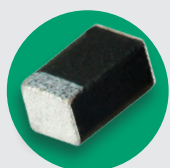
8



SiHG73N60E E 系列 600 V 高压 MOSFET

*具有非常低导通电阻的 600 V,
TO-247 MOSFET。*

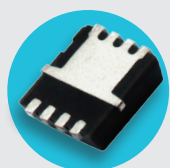
9



TM8 MicroTAN® 钽电容器

*用于医疗和军工应用的高可靠性
电容器方案。*

10



SiSA04DN 30 V MOSFET

*使用TrenchFET® Gen IV 技术的
30 V MOSFET。*

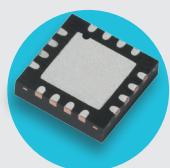
11



TNPU e3 高精度 薄膜片式电阻

低温度系数和严格的容差。

12



SIP12107/8 可扩展的降压稳压器

*3 A / 5 A 输出电流, 开关频率 4 MHz, 采用
MLP33-16L 封装, 在满载和轻负载条件下
以高频工作, 提供超快瞬态响应。*

13



Super 12
特色产品

威世

被动元件

MKP1848S 薄膜电容器

薄身外型的薄膜电容器。



特性：

- ▶ 薄身外型 - 小尺寸
- ▶ 电压范围：500 V ~ 1000 V
- ▶ 容量：2 μ F ~ 100 μ F
- ▶ 可处理高 RMS 和峰值电流
- ▶ 长寿命：在 U_{NDC} 和 70 °C 条件下的寿命超过 100 000 小时
- ▶ 工作温度：高达 105 °C

应用：

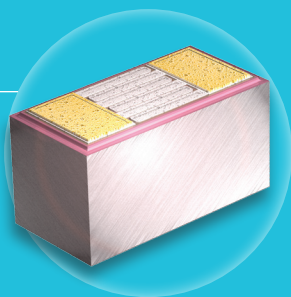
- ▶ 再生能源：
太阳能微逆变器
- ▶ 公共照明：LED 驱动器
- ▶ 混合动力电动汽车：电路板上充电

S12

PASSIVES

VCUT05D1-SD0 BiSy 单线 ESD 保护二极管

超小 CLP0603 硅封装。



特性：

- ▶ 超小 CLP0603 封装
 - 小尺寸 0.6 mm x 0.3 mm 占位
 - 非常低的封装高度，小于 0.3 mm
- ▶ 10 pF 的小容量
- ▶ 在 5.5 V 工作电压下的泄漏电流小于 0.1 μ A
- ▶ 在 1 mA 电流下反向击穿电压为 8 V
- ▶ 在 1 A 电流下最大钳位电压为 10 V

应用：

- ▶ 便携式游戏机、数码相机、MP3播放器、手机、智能手机和其他便携式系统的 ESD 保护

S12

SEMIS



Super 12
特色产品

威世

被动元件



34 THE 非接触式 多匝传感器

真正的 12 位分辨率
电源导通位置传感器。
角度和输出电压完全可配置。



特性：

- ▶ 在器件的寿命周期内保持性能连续稳定：线性度无漂移
- ▶ 适用于恶劣环境中应用的非接触式霍尔效应技术
- ▶ 多种输出类型：模拟，PWM，SPI
- ▶ 可设定为任何电角度，最高为 3600°
- ▶ 荣获 EDN China 2011 年创新奖

应用：

- ▶ 电动机的伺服控制
- ▶ 用做轮船或电动车转向轮上的“主控装置”
- ▶ 用做方向舵位置（海军舰艇）设定的“从动装置”
- ▶ 自卸叉车的前轮定位控制
- ▶ 包含齿轮驱动的机器人应用（替代多匝绕线精密电位计）

S12

PASSIVES

Super 12
特色产品



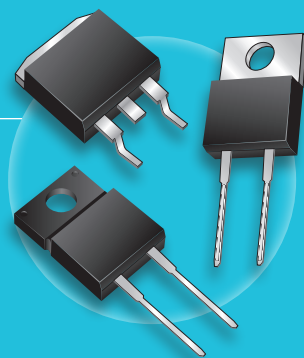
威世

半导体

EN-Genius
NETWORK
Product of the Year

45 V Trench MOS 势垒 肖特基整流器

采用功率封装的45 V TMBS[®]，可
用于光伏太阳能电池旁路保护。



特性：

- ▶ 额定电流：10 A ~ 40 A
- ▶ 低正向压降：在 20 A 电流下典型压降低至 0.51 V
- ▶ 每种器件均提供功率 TO-220AC、ITO-220AC 和 TO-263AB 封装
- ▶ 在直流正向电流模式且无反向偏置（时间 ≤ 1 小时）条件下的最高结温为 200 °C
- ▶ 荣获 EN-Genius 的 2011 年度产品奖

应用：

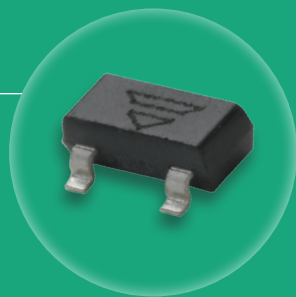
- ▶ 在太阳能电池接线盒中用于旁路二极管保护

S12

SEMIS

MPM 配对 电阻网络

**具有严格的比例容差和接近的
TCR 跟踪。**



特性：

- ▶ 小尺寸，SOT-23 封装
- ▶ 常用的电阻分配器 1:1 ~ 100:1
- ▶ 严格的比例容差： $\pm 0.01\%$ 等值
- ▶ 低 TCR 跟踪： $\pm 2.0 \text{ ppm}/^\circ\text{C}$
- ▶ 优异的长期稳定率：在 70°C 下经过 2000 小时的 ΔR 比例为 $\pm 0.015\%$

应用：

- ▶ 工业：过程控制，测试和测量，仪表，信号处理，数据采集

S12

PASSIVES

Super 12
特色产品



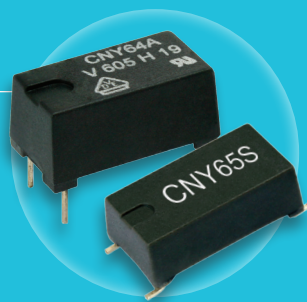
威世

半导体

EN-Genius
NETWORK
Product of the Year

CNY6 系列 CAT IV 光耦

CAT IV, 为太阳能电池、风电、智能电表和智能电网连接提供高压隔离。



特性：

- ▶ 通过 CAT IV 装置 DIN EN 60747-5-2 (VDE 0884) 的认证
- ▶ 循环峰值电压 (V_{IORM}) 达到 $1450 V_{PEAK}$
- ▶ 瞬态过压达到 (V_{IOTM}) $12\ 000 V_{PEAK}$
- ▶ 爬电距离为 9.5 mm, 14 mm, 和 17 mm
- ▶ 发射器与探测器之间的隔离距离 $\geq 3\ mm$
- ▶ 提供表面贴装和通孔封装

应用：

- ▶ 太阳能电池和风电机组的电网接入
- ▶ 智能电表和智能电网的高压隔离
- ▶ 焊接和高压电机

S12

SEMIS



Super 12
特色产品

威世

被动元件

IHLP® 3232 系列 小尺寸、高电流 电感器

为 IHLP 产品线新增尺寸。



特性：

- ▶ 新尺寸填补 IHLP 占位产品线的空白
- ▶ 两种标准外形：3 mm 和 4 mm
- ▶ 屏蔽结构
- ▶ 可用于 5 MHz 的应用

应用：

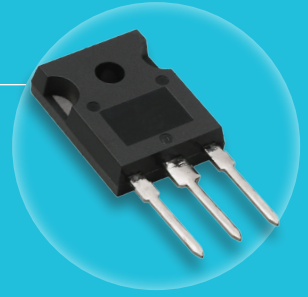
- ▶ PDA / 笔记本电脑 / 桌面电脑 / 服务器应用，高电流 POL 转换器，小尺寸、高电流电源，电池供电设备，分布式电源系统中的 DC/DC 转换器
- ▶ 可根据需要提供汽车级系列产品

S12

PASSIVES

SiHG73N60E E 系列 600 V 高压 MOSFET

具有非常低导通电阻的
600 V, TO-247 MOSFET。



特性：

- ▶ 最小击穿电压达 600 V
- ▶ TO-247 封装提供了最低的导通电阻
- ▶ 超级结技术
 - 低 $R_{DS(on)} \times Q_g$ 优值系数 (FOM)
 - 减少开关和导通损耗
 - 超低栅极电荷 (Q_g)
 - 低输入电容 (C_{iss})

应用：

- ▶ 可再生能源 (光伏逆变器)
- ▶ 服务器 / 通信 SMPS (开关电源)
- ▶ ATX 电源 (ATX = 先进技术扩展, 用于电脑主板)
- ▶ 工业电源 (焊接, UPS, 电池充电器)

S12

SEMIS



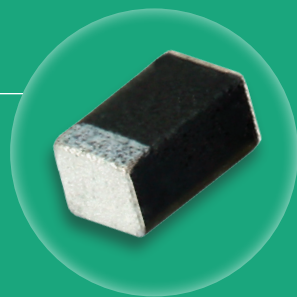
Super 12
特色产品

威世

被动元件

TM8 MICROTAN[®] 钽电容器

用于医疗和军工应用的高可靠性电容器解决方案。



特性：

- ▶ 坚实的产品设计确保最高的可靠性
- ▶ 小外形尺寸提供有限空间应用的绝佳选择
- ▶ 自定可靠性的筛选选项：
根据应用的需要选择合适的筛选要求
- ▶ 低 DCL：高效工作和长电池寿命

应用：

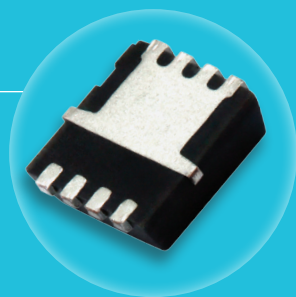
- ▶ 手持式仪表
- ▶ 生物识别传感器
- ▶ 混合集成电路
- ▶ 助听器
- ▶ 神经刺激器，心脏起搏器和其他植入式设备

S12

PASSIVES

SiSA04DN 30 V MOSFET

使用 TrenchFET® Gen IV 技术的
30 V MOSFET。



特性：

- ▶ 使用目前最先进的 TrenchFET Gen IV 技术，在 3.3 mm x 3.3 mm 外形尺寸内将最大导通电阻降至 2.15 mΩ
- ▶ 典型栅极电荷低至 22.5 nC，FOM 低至 56
- ▶ 最低的 $R_{DS(on)} * Q_{gd}$ 实现了最高效的高频开关
- ▶ 低 Q_{gd} 和低 $Q_{gd} : Q_{gs}$ 比实现良好的防止共通的能力
- ▶ 热增强型 PowerPAK® 1212-8 封装

S12

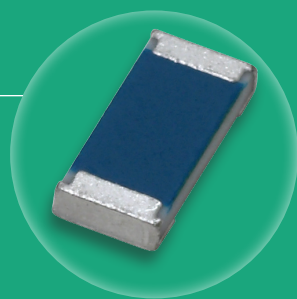
应用：

- ▶ 同步整流 – 隔离 DC / DC 电源 / 通信砖式电源
- ▶ 同步降压转换器 – 低边 MOSFET
- ▶ OR-ing，热插拔，固态继电器

SEMIS

TNPU e3 高精度薄膜片式电阻

低温系数和严格的容差。



特性：

- ▶ 低温系数 (± 5 ppm/K) 和严格的容差 ($\pm 0.05\%$)
- ▶ $< 0.25\%$ 的优异水汽电阻率 (56 天 / 85°C / 85% 相对湿度)
- ▶ 通过 AEC-Q200 认证
- ▶ 耐废气

应用：

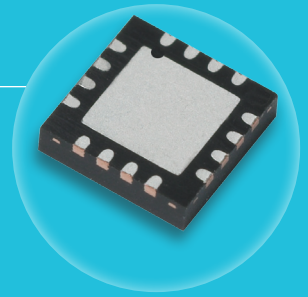
- ▶ 测试和测量设备
- ▶ 医疗设备
- ▶ 汽车
- ▶ 仪表

S12

PASSIVES

SIP12107/8 可扩展的 降压稳压器

**3 A / 5 A 电源，开关频率达
4 MHz，采用 MLP33-16L 封装，
高频率可提供超快瞬态响应，
在满载和轻负载下具有高效率。**



特性：

- ▶ 在整个负载范围内保持高效率
- ▶ 开关频率高达 4 MHz
- ▶ 在高频下具有超快的瞬态响应
- ▶ 支持全部陶瓷电容器方案
- ▶ 过压保护，欠压保护，过温保护，电源正常信号

应用：

- ▶ 超高性能系统的负载点 (POL) 稳压
- ▶ 为 DSP, FPGA, ASIC 和微处理器供电
- ▶ 通信，服务器
- ▶ 笔记本电脑，固态硬盘

S12

SEMIS



威世

全球销售联络

北美 THE AMERICAS

美国 UNITED STATES

VISHAY AMERICAS
ONE GREENWICH PLACE
SHELTON, CT 06484
UNITED STATES
PH: +1-402-563-6866
FAX: +1-402-563-6296

亚洲 ASIA

新加坡 SINGAPORE

VISHAY INTERTECHNOLOGY ASIA PTE LTD.
37A TAMPINES STREET 92 #07-00
SINGAPORE 528886
PH: +65-6788-6668
FAX: +65-6788-0988

中国 P.R. CHINA

VISHAY CHINA CO., LTD.
15D, SUN TONG INFOPORT PLAZA
55 HUAI HAI WEST ROAD
SHANGHAI 200030
P.R. CHINA
PH: +86-21-5258 5000
FAX: +86-21-5258 7979

日本 JAPAN

VISHAY JAPAN CO., LTD.
SHIBUYA PRESTIGE BLDG. 4F
3-12-22, SHIBUYA
SHIBUYA-KU
TOKYO 150-0002
JAPAN
PH: +81-3-5466-7150
FAX: +81-3-5466-7160

欧洲 EUROPE

德国 GERMANY

VISHAY ELECTRONIC GMBH
DR.-FELIX-ZANDMAN-PLATZ 1
95100 SELB
GERMANY
PH: +49-9287-71-0
FAX: +49-9287-70435

法国 FRANCE

VISHAY S.A.
199, BD DE LA MADELEINE
06003 NICE, CEDEX 1
FRANCE
PH: +33-4-9337-2727
FAX: +33-4-9337-2726

英国 UNITED KINGDOM

VISHAY LTD.
SUITE 6C, TOWER HOUSE
ST. CATHERINE ' S COURT
SUNDERLAND ENTERPRISE PARK
SUNDERLAND SR5 3XJ
UNITED KINGDOM
PH: +44-191-516-8584
FAX: +44-191-549-9556

威世(中国)投资有限公司

上海 SHANGHAI

电话: 86-21-5258-5000
传真: 86-21-5258-7979

深圳 SHENZHEN

电话: 86-755-8358-8508
传真: 86-755-8358-8488

北京 BEIJING

电话: 86-10-6568-1399
传真: 86-10-6568-0232

香港 HONGKONG

电话: 852-2353-2828
传真: 852-2353-2233

台北 TAIPEI

电话: 886-2-2918-7575
传真: 886-2-2918-7272

Build Vishay into your Design

www.vishay.com/ref/2012S12

本文件如有更改, 恕不另行通知。这里描述的产品和文件适用于特定的免责声明, 详见 www.vishay.com/doc?91000

